

CONTENTS

Verner V. D., Ivanov A. A., Kolomenskaya N. G., Luchinin V. V., Maljtcev P. P., Popova I. V., Saurov A. N., Teletc V. A. <i>The Produces of Microsystems Techniques — Fundamental Ideals and Terms</i>	2
Vroublevskiy E. M., Kireev V. Yu., Nedzvetskiy V. S., Sosnovtsev V. V. <i>The Nanotechnology. Is this a Way into the Future or a Brand for the Financing?</i>	6
Kuznetsov M. A., Mishina E. D., Morozov A. I., Sigov A. S., Golovko Yu. I., Muhortov V. M., Moshnyaga V. T. <i>Magnetelectric and Nonlinear Optical Properties of Thin Films of BiFeO₃ Doped with Nd Ions</i>	20
Vasiliev V. A., Seregin D. S., Vorotilov K. A. <i>Hybrid Porous Silicate Films with Controlled Nanostructure</i>	23
Petrovich E. V., Kabirov Yu. V., Kofanova N. B., Redichkin B. M., Kupriyanov M. F. <i>Phase Transitions in System of Firm Solutions on the Basis of PZT</i>	29
Luchnikov A. P., Luchnikov P. A., Sigov A. S. <i>Microstructure and Electrical Properties of Vacuum Fluoropolymer Films for MEMS and Nanodevices</i>	34
Panahov M. M., Agasiyev A. A., Sarmasov S. N. <i>Dependence of Conductance of the Semiconductive Films PbTe on the Polarization of State of the Ferroelectrics</i>	40
Pecherskaya Y. A. <i>The Metrological Analysis of Equipment for Ferroelectric Electrophysical Properties Measurements of Samples with Linear Sizes of Micrometer Range</i>	43
Mustafaev G. A., Mustafaev A. G. <i>Radiation resistance of SOI Mosfet to Total Ionizing Dose</i>	47
Belozubov E. M., Belozubova N. E. <i>Thin-Film Resistive-Strain Pressure Sensors are Nano-and Microsystem Engineering Products</i>	49
Adamov D. Yu., Matveenko O. S. <i>Destabilizing Factors in a Nanometer CMOS Circuits and Methods of Controlling them</i>	51
Novikov S. G., Gurin N. T., Korneev I. V., Terentiev M. A. <i>Positioning Device Based on Semi-Conductor Positionally-Sensitive Photogauge with Negative Conductivity</i>	58
Makarov V. M., Ivanov P. G., Zaya V. G. <i>Ladder SAW Filters</i>	60
Timofeev V. N., Sajnev S. V., Fomichev M. A., Mirkurbanov H. A. <i>About Thermomechanical Stiffness on Threadlike Sensors in Microelectromechanical Systems</i>	66
Sherstnev P. V., Sheshin E. P., Lamanov M. M. <i>Method of Express Training and Testing for the Field Emission Cathode Prepared from Graphite Foil</i>	70

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)

The journal bought since november 1999.

Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev

ISSN 1813-8586.

Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.

E-mail: nmst@zknet.ru; http://www.microsystems.ru

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромьинский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: nmst@zknet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер Т. Н. Погорелова. Технический редактор Е. М. Патрушева. Корректор М. Г. Джавадян

Сдано в набор 15.10.2007. Подписано в печать 26.11.2007. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 12,08. Заказ 489. Цена договорная

Отпечатано в ООО "Подольская Периодика", 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15